Bi₂Sn₂O₇掺杂对 Ag/SnO₂材料界面润湿性 及物理性能的影响

郑晓华1,王 纯1,沈 涛2,秦海波1,杨芳儿1

(1. 浙江工业大学,浙江 杭州 310014)
 (2. 浙江大学,浙江 杭州 310027)

摘 要:以化学共沉淀法合成的锡酸铋(Bi₂Sn₂O₇)为改性组元,采用座滴法研究了Bi₂Sn₂O₇掺杂对Ag/SnO₂界面润湿角的影响规律,并利用机械合金化技术结合成型烧结工艺制备了Ag/SnO₂(x)-Bi₂Sn₂O₇(y)电接触材料。采用扫描电镜、X射线衍射仪、视频光学接触角测量仪、电阻测试仪、硬度计以及密度计等表征手段对材料的物相结构、电学及力学性能进行了表征。结果表明:所合成的Bi₂Sn₂O₇粉体呈无规则颗粒状,尺寸在1~10 μm。Bi₂Sn₂O₇掺杂能明显改善Ag与SnO₂之间界面润湿性,并且Bi₂Sn₂O₇质量分数在16.7%时润湿角最小为82°。Ag与SnO₂之间的润湿角越小,Ag/SnO₂(x)-Bi₂Sn₂O₇(y)电接触材料的电阻率越低,尤其在锡酸铋掺杂质量分数为2%时电阻率达到最低值,为2.28 μΩ·cm,致密度和硬度HV_{0.3}达到最大值,分别为96.96%和900 MPa。

关键词: Ag/SnO₂; Bi₂Sn₂O₇掺杂; 电接触材料; 润湿性; 电阻率 中图法分类号: TM501⁺.3 文献标识码: A 文章编号: 1002-185X(2022)02-0552-07

Ag/CdO 电接触材料因其优良抗电弧侵蚀能力、抗 熔焊性能以及较低的接触电阻而被广泛应用于继电器、 低压断路器和接触器等低压电器中^[1-5]。但是,由于其服 役过程中产生的 Cd 蒸气对人体有害且污染环境,中国 与欧盟己在许多电器产品中限制了 Ag/CdO 的使用。研 究发现,环保型电接触材料 Ag/SnO₂ 不仅具有与 Ag/CdO 相近的抗电弧侵蚀性、抗熔焊性,且耐电磨损性与低材 料转移特性良好,是作为替代 Ag/CdO 电接触材料的最 优选择^[6-10]。诸多高校与企业对 Ag/SnO₂ 材料展开了大 量研究,发现液态银与 SnO₂ 颗粒之间的润湿性较差,在 电弧侵蚀作用下, SnO₂ 颗粒易脱离银基体并于表面发生 偏析聚集,导致接触电阻增大,进而直接弱化了该材料 的服役性能^[11]。

已有研究表明,添加金属元素(Ti、Bi、La)^[12-14]或氧 化物(CuO、Fe₂O₃、Bi₂O₃)^[15-17]可以改善Ag和SnO₂之间 的界面润湿性,从而改善Ag/SnO₂材料的服役能力。陈 勇等^[18]通过添加Bi₂O₃使Ag/SnO₂电接触材料硬度升高, 电阻率下降,抗电弧侵蚀能力上升。浙江大学吴新合^[19] 等在AgSnO₂Bi₂O₃电接触材料的电弧侵蚀过程中发现 SnO₂与Bi₂O₃之间形成了锡酸铋(Bi₂Sn₂O₇)。刘辉^[20] 等亦报道指出新相Bi₂Sn₂O₇的存在有助于显著提升 Ag/SnO₂ 材料的抗电弧熔焊能力和耐电弧磨损性能,抑制了 SnO₂ 颗粒相在电弧作用下于熔池表面发生析出现象。笔者推断这一新相 Bi₂Sn₂O₇可能有助于更好地改善Ag/SnO₂ 材料的界面润湿特性及其物理性能。

为此,本研究以自制的 Bi₂Sn₂O₇ 粉体为改性组元, 首先采用粉末冶金工艺制备不同 Bi₂Sn₂O₇ 配比含量的 SnO₂-Bi₂Sn₂O₇ 陶瓷基片,采用座滴法探究 SnO₂-Bi₂Sn₂O₇ 陶瓷基片在液态 Ag 中的界面润湿特性;利用高能球磨 结合粉末冶金法制备 Ag/SnO₂(x)-Bi₂Sn₂O₇(y)电接触材 料,并分析其物理性能变化规律,为提升 Ag/SnO₂电接 触材料的综合性能提供参考价值。

1 实 验

采用化学共沉淀法制备出 Bi₂Sn₂O₇ 粉体。配置 100 mL 的 0.1 mol Bi/Sn 混合溶液,将 2.450 g Bi(NO₃)₃ 5H₂O(0.05 mol)溶于 50 mL 稀盐酸中,1.361 g 锡 酸钠(0.05 mol)溶于 50 mL 去离子水中,待溶解完全,将 锡酸钠溶液加入到 Bi(NO₃)₃ 5H₂O 溶液中,均匀搅拌, 转速 500 r/min,随后加入柠檬酸 1.906 g,聚乙二醇-2000 0.200 g,持续搅拌 30 min,加入氨水,pH 调至 10,持 续搅拌 30 min,陈化 1 h,移去上清液,采用去离子水

基金项目:浙江省重点研发计划(2017C01051)

收稿日期: 2021-05-10

作者简介: 郑晓华, 男, 1971 年生, 博士, 副教授, 浙江工业大学材料科学与工程学院, 浙江 杭州 310014, 电话: 0571-88320479, E-mail: zhengxh@zjut.edu.cn

和无水乙醇洗涤 2~3 次,随后置入干燥箱 80 ℃干燥 12h,得到白色锡酸铋前驱体,将其放入马弗炉中 600 ℃ 焙烧5h。最终合成了黄色锡酸铋粉体。

采用高能球磨法结合成型烧结工艺制备陶瓷基片。首 先,将 SnO₂、Bi₂Sn₂O₇粉体按不同质量配比分别置于行 星式球磨机中进行机械合金化处理,球磨罐和球磨珠均为 玛瑙,球料比为 3:1,转速 300 r/min,时间 3 h;其次, 将充分混合后的粉体进行烘干、压制成形(压力 30 MPa, 保压时间 30 s);随后将基片放入马弗炉中烧结,升温速 率为 10 ℃/min,至 1200 ℃时保温 2 h;最后将制得的 SnO₂-Bi₂Sn₂O₇陶瓷基片表面进行打磨、抛光、清洗。SnO₂ 与 Bi₂Sn₂O₇粉体的质量比见表 1 (1#~5#)。

采用座滴法探究 SnO₂-Bi₂Sn₂O₇陶瓷基片在液态 Ag 中的界面润湿特性。首先将尺寸为 *ϕ*1 mm×1 mm 的银块 置于陶瓷基片上,然后放入高温箱式电阻炉中加热至 1150 ℃并保温 30 min,以使银块形成熔滴后在陶瓷基片 上充分铺展;待样品冷却到室温后,采用视频光学接触 角测量仪测量其润湿角。

采用机械合金化结合成型烧结工艺制备 Ag/SnO₂(x)-Bi₂Sn₂O₇(y)电接触材料。首先,采用高能球 磨工艺制备Ag/SnO₂(x)-Bi₂Sn₂O₇(y)复合粉体,其中,Ag 与SnO₂(x)-Bi₂Sn₂O₇(y)质量比为88:12,设备选用行星式 球磨机、玛瑙球磨罐,球料比3:1,转速300 r/min,时 间3h;其次,利用成型烧结工艺制备出Ag/SnO₂(x)-Bi₂Sn₂O₇(y)电接触材料,成型压力为30 MPa,保压时间 30 s,烧结温度为850 ℃,烧结时间6h。Ag/SnO₂(x)-Bi₂Sn₂O₇(y)材料配比见表1(6#~10#)。

采用 ΣIGMA 型蔡司场发射扫描电镜观察混合粉体以及 Ag 与陶瓷基底横截面形貌;采用 Thermo X' TRAX 型射线衍射仪分析物相组成;采用视频光学接触角测量仪(OCA20)测量润湿角。采用 D60K 型数字金属电导率仪测量电接触材料电阻率;采用 TCYQ-228 型数显显微硬度计测量硬度;采用 JF-120SD 型密度计测量密度。

表1 陶瓷基片样品中 Bi₂Sn₂O₇ 掺杂量与 Ag/SnO₂(x)-Bi₂Sn₂O₇(y) 材料配比

 Table 1
 Bi₂Sn₂O₇ doping amount in ceramic substrate samples

and ratio of Ag/SnO ₂ (x)-Bi ₂ Sn ₂ O ₇ (y) (ω /%)								
Sample	$Bi_2Sn_2O_7$	Sample	SnO_2	$Bi_2Sn_2O_7$				
1#	0	6#	12	0				
2#	16.7	7#	10	2				
3#	33.3	8#	8	4				
4#	50.0	9#	6	6				
5#	83.3	10#	2	10				

2 结果与讨论

2.1 Bi₂Sn₂O₇粉体

图 1 为化学共沉淀法所制备的 Bi₂Sn₂O₇ 粉体 XRD 图谱。由图谱可知,该粉体的衍射峰尖锐,且半高宽小, 结晶性良好,且无其他杂峰,物相较纯。

图 2 为 Bi₂Sn₂O₇粉体的 SEM 照片。从图中可以看出 微米级的 Bi₂Sn₂O₇颗粒大小不均匀,其范围介于 1~10 μm, 造成此现象的原因是在反应过程中,颗粒与颗粒之间极 易发生团聚,大量细小颗粒发生聚集形成大颗粒。

2.2 SnO₂-Bi₂Sn₂O₇复合粉体

图 3a 为 SnO₂-Bi₂Sn₂O₇复合粉体的 XRD 图谱。所 有复合粉体的物相结构均由 SnO₂ 和 Bi₂Sn₂O₇构成,随 着锡酸铋掺杂量的增加, SnO₂ 的峰强逐渐减弱, Bi₂Sn₂O₇(图中简写为 BSO)峰强逐渐增强。这表明在机 械合金化过程中 SnO₂ 与 Bi₂Sn₂O₇粉体之间并未发生化 学反应。由图 3b 放大图进一步分析可知,相比于纯 SnO₂ 粉体而言, SnO₂-Bi₂Sn₂O₇复合粉体中 SnO₂相晶面指数 (110)、(101)与(211)对应的峰位向高角度方向发生约 0.2° 的偏移,这可能归因于锡酸铋中的 Bi 原子掺入至





Fig.1 XRD pattern of Bi₂Sn₂O₇ powders



图 2 Bi₂Sn₂O₇粉体 SEM 照片 Fig.2 SEM image of Bi₂Sn₂O₇ powder





Fig.3 XRD patterns of SnO₂-Bi₂Sn₂O₇ composite powders (a) and its local magnification (b)

 SnO_2 的晶格内,造成晶体结构的微小变化。

图 4a 为纯二氧化锡(SnO₂)的微观形貌照片。SnO₂ 粉体颗粒大小均匀,尺寸在 0.2~1 µm,分散性良好,存 在少量团聚现象。图 4b~4d 和图 4f 为 SnO₂-Bi₂Sn₂O₇复 合粉体形貌照片。图 4e 为对应图 4b 区域的 EDS 分析结 果。复合粉体具有良好的分散均匀性,少部分颗粒以团 聚态形式存在。

2.3 界面润湿角与润湿形貌

图 5 为 Ag 与 SnO₂-Bi₂Sn₂O₇基底润湿形貌与润湿 角。根据 T. Yong 提出的杨氏方程,材料表面润湿性与 各相界面之间的界面张力存在定量关系:

$$\delta_{\rm SG} = \delta_{\rm SL} + \delta_{\rm LG} \cos\theta \tag{1}$$

$$\cos\theta = \frac{\delta_{\rm SG} - \delta_{\rm SL}}{\delta_{\rm LG}} \tag{2}$$

其中, δ_{SG} 为固气界面张力, δ_{LG} 表示固液界面张力, δ_{SL} 表示液气界面张力, θ 表示固相表面与液相的接触角, 也叫润湿角。润湿角的大小决定润湿性的好坏,当 $\theta=0^{\circ}$ 时,表示两相间完全润湿;当 $0 \ll \theta < 90$ 时的状态称为 润湿;当 $90 \ll \theta < 180$ 时的状态称为不润湿^[21]。

根据固液界面有无发生化学反应将润湿分为反应性 润湿和非反应性润湿。由于在 1150 ℃液态银化学性质仍 较为稳定,与固相的 SnO₂-Bi₂Sn₂O₇ 陶瓷基底并未发生 反应,故属于非反应性润湿。非反应性润湿过程中,液 固界面间的结合主要通过扩散力和范德瓦尔斯力,界面 结合力越强,则界面张力越小,反之界面结合力越弱, 对应的界面张力越大。由公式(2)可知,在固气界面张力 $δ_{SG}$ 与液气界面张力 $δ_{LG}$ 一定时,固液界面张力 $δ_{SL}$ 越大, 润湿角θ越大。



图 4 SnO₂-Bi₂Sn₂O₇ 混合粉体 SEM 照片及 EDS 分析

Fig.4 SEM images and EDS analysis of SnO₂-BiSn₂O₇ mixed powders: (a) 1#, (b, e) 2#, (c) 3#, (d) 4#, and (f) 5#



图 5 Ag 与 SnO₂-Bi₂Sn₂O₇基底润湿形貌与润湿角 Fig.5 Wetting morphologies (a~e) and wetting angle (f) of Ag and SnO₂-Bi₂Sn₂O₇ substrate

图 5a 为未掺杂锡酸铋的 SnO₂陶瓷基底与 Ag 液滴的 润湿形貌,润湿角为 138°,属于不润湿状态;而掺杂了 锡酸铋的 SnO₂陶瓷基底与 Ag 液滴间润湿角都低于138°, 且在掺杂量为 16.7%时,润湿角达到最小值为 82°,属于 润湿状态 (见图 5b);图 5c~5e 示出为锡酸铋掺杂量分别 为 33.3%、50.0%和 83.3%的 SnO₂陶瓷基底与 Ag 液滴的 润湿形貌,随着锡酸铋掺杂量增加,润湿角从 82°逐渐增 加至 125°,界面润湿性由润湿状态向不润湿状态转变。

图 6 为 Ag 与 SnO₂-Bi₂Sn₂O₇陶瓷基底横截面 SEM 照片。由于 Ag 液滴与未掺杂锡酸铋的 SnO₂陶瓷基底之

间界面结合强度较弱,在磨抛过程中发生脱落,故无法 对 Ag/SnO₂界面层进行观察。由图 6a 可知,氧化物基底 与 Ag 之间结合较为紧密,结合强度较高,无任何空隙 和脱落痕迹;图 6b 中界面结合强度弱,无任何空隙 强度高;图 6c,6d 中的界面结合强度弱,有明显脱落迹 象。锡酸铋掺杂量 16.7%时,Ag 与 SnO₂陶瓷基底的结 合力最强,这是因为少量的锡酸铋掺杂降低了界面张力, 使结合力增强,润湿角减小。当掺杂量过多时,降低界 面张力的效果不佳,Ag 与基底间结合力不高,表现出较 大的润湿角。



图 6 Ag 与 SnO₂-Bi₂Sn₂O₇基底横截面微观结构

Fig.6 Cross section microstructures of Ag and SnO₂-Bi₂Sn₂O₇ substrate with different BSO contents: (a) 16.7%, (b) 33.3%, (c) 50.0%, and (d) 83.3%

2.4 Ag/SnO₂(x)-Bi₂Sn₂O₇(y)材料

图 7 为各组分 $Ag/SnO_2(x)-Bi_2Sn_2O_7(y)材料的 XRD$ 图谱,在未掺杂 $Bi_2Sn_2O_7$ 的试样中,只有 Ag 和 SnO_2 的衍射峰,随着 $Bi_2Sn_2O_7$ 掺杂量的增多, SnO_2 的衍射峰 峰强度变弱, $Bi_2Sn_2O_7$ 的衍射峰峰强逐渐增强。

表 2 为 Ag/SnO₂(x)-Bi₂Sn₂O₇(y)电接触材料的物理性 能测试结果。由表 2 可知,未掺杂 Bi₂Sn₂O₇的 Ag/SnO₂ 电接触材料电阻率达到最大值为 2.59 $\mu\Omega$ ·cm,掺杂了 Bi₂Sn₂O₇的 Ag/SnO₂ 电接触材料的电阻率均低于 2.59 $\mu\Omega$ ·cm,说明 Bi₂Sn₂O₇的掺入可以有效地降低 Ag/SnO₂(x)-Bi₂Sn₂O₇(y)电接触材料的电阻率;当锡酸铋 含量为 2%时,材料的电阻率达到最低值为 2.28 $\mu\Omega$ ·cm。 随着锡酸铋掺杂量的增加,电阻率呈单调上升趋势,该



图 7 不同 BSO 含量 Ag/SnO₂(x)-Bi₂Sn₂O₇(y)材料 XRD 图谱

Fig.7 XRD patterns of $Ag/SnO_2(x)-Bi_2Sn_2O_7(y)$ materials with different BSO contents

表 2 不同 BSO 含量 $Ag/SnO_2(x)$ -Bi₂Sn₂O₇(y)物理性能

 Table 2
 Physical properties of Ag/SnO₂(x)-Bi₂Sn₂O₇(y) with different BSO contents

Sample	6#	7#	8#	9#	10#
Resistance/ $\mu\Omega$ cm	2.59	2.28	2.33	2.49	2.57
Hardness, HV _{0.3} /×10 MPa	89.6	90.0	89.1	88.4	86.7
Relative density/%	95.98	96.96	96.24	95.51	94.48
Porosity/%	4.02	3.04	3.76	4.49	5.52

影响规律与润湿角影响规律相一致。进一步证实了锡酸 铋的掺杂改性可以有效地降低 Ag 基体相与 SnO₂ 增强相 之间的界面润湿角,形成良好的连续结合界面,减弱电 子的散射能力,从而降低材料的电阻率^[1]。

 $Ag/SnO_2(x)-Bi_2Sn_2O_7(y)材料的致密度(y)可先通过公式(3)计算出其理论密度(<math>\rho_0$),再根据公式(4),代入实际密度(ρ),最终得出相应的致密度(γ)。

$$\frac{1}{\rho_{0}} = \frac{\omega_{\text{SnO}_{2}}}{\rho_{\text{SnO}_{2}}} + \frac{\omega_{\text{Bi}_{2}\text{Sn}_{2}\text{O}_{7}}}{\rho_{\text{Bi}_{2}\text{Sn}_{2}\text{O}_{7}}} + \frac{\omega_{\text{Ag}}}{\rho_{\text{Ag}}}$$
(3)

$$\gamma = \frac{\rho}{\rho_0} \times 100\% \tag{4}$$

$$\theta = 1 - \gamma \tag{5}$$

其中, ω_{SnO_2} 、 $\omega_{Bi_2Sn_2O_7}$ 和 ω_{Ag} 分别为 SnO₂、 $Bi_2Sn_2O_7$ 和 Ag 的质量分数, 且已知 SnO₂、 $Bi_2Sn_2O_7$ 和 Ag 的理论密 度分别为 6.95、8.27 和 10.49 g/cm³。

图 8 为各组分 Ag/SnO₂(x)-Bi₂Sn₂O₇(y)电接触材料自



图 8 Ag/SnO₂(x)-Bi₂Sn₂O₇(y)自然断口形貌

Fig.8 Natural fracture morphologies of Ag/SnO₂(x)-Bi₂Sn₂O₇(y) materials with different BSO contents: (a) 0%, (b) 2%, (c) 4%, (d) 6%, and (e) 10%

然断口形貌。可以看到,未掺杂锡酸铋的 Ag/SnO₂材料 断口中有较多的孔隙,而掺杂 2%锡酸铋的 Ag/SnO₂材 料孔隙相对较少,并且随着掺杂量的增加,孔隙在逐渐 增多。从表 2 可知,未掺杂锡酸铋的 Ag/SnO₂材料致密 度为 95.98%,而在锡酸铋掺杂量为 2%时的致密度达到 最大值,为 96.96%。随着锡酸铋掺杂量增加,致密度反 而呈下降趋势,在掺杂量为 10%时致密度出现最小值, 为 94.48%。这是因为少量锡酸铋的加入提高了相与相间 的界面结合能力,界面结合更为紧密,孔隙率更低,致 密度高。过量锡酸铋的加入使致密度下降,这可能归因 于锡酸铋颗粒较大,从而导致孔隙率增加。

同理, Ag/SnO₂(x)-Bi₂Sn₂O₇(y)电接触材料硬度随 着 Bi₂Sn₂O₇含量变化的关系如表 2 所示。当 Bi₂Sn₂O₇ 掺杂量 0%时, Ag/SnO₂ 材料的硬度为 896 MPa。 Bi₂Sn₂O₇掺杂量 2%的材料硬度达到最高值 900 MPa, 但当掺杂量继续增加时,材料的硬度反而呈小幅度下 降趋势。其可能原因是材料的孔隙率增大,材料的致 密度降低。

3 结 论

 Bi₂Sn₂O₇ 掺杂能提高 Ag 与 SnO₂之间结合强度, 改善润湿性。且 Bi₂Sn₂O₇ 质量分数为 16.7%时润湿角最 小为 82°。

2) Ag/SnO₂(x)-Bi₂Sn₂O₇(y)电接触材料电阻率大小跟 Ag 与 SnO₂ 之间润湿角大小成正相关,相比于纯 Ag/SnO₂,锡酸铋掺杂量为 2%时,电阻率达到最小值 2.28 μΩ·cm,致密度和硬度达到最大值,分别为 96.96% 和 900 MPa。

参考文献 References

- [1] Yang Fanger(杨芳儿), Wang Guicong(王贵葱), Mu Chengfa(穆成法) et al. Rare Metal Materials and Engineering(稀有金属材料与工程)[J], 2020, 49(4): 1301
- [2] Zhu Yancai(朱艳彩), Wang Jingqin(王景芹), Wang Haitao(王海涛). Electrical Materials(电工材料)[J], 2006, 34(3): 3
- [3] Qiu Kaifeng(裘凯锋), Yang Fanger(杨芳儿), Cai Jiangnan(蔡江南) et al. Hot Working Technology(热加工工艺)[J], 2014, 43(22):19
- [4] Zhou Xiaolong(周晓龙), Chen Jingchao(陈敬超), Sun Jialin(孙加林) et al. The Chinese Journal of Nonferrous Metals(中国有色金属学报)[J], 2006, 16(5): 829
- [5] Zhen Xiaohua(郑晓华), Wang Guicong(王贵葱), Zhang

Lingjie(张玲洁) et al. Hot Working Technology(热加工工艺)[J], 2020, 49(14): 75

- [6] Xu Canhui(许灿辉), Yi Danqing(易丹青), Cao Shiyi(曹适意) et al. The Chinese Journal of Nonferrous Metals(中国有色金属 学报)[J], 2011, 21(9): 2091
- [7] Li Hangyu, Wang Xianhui, Hu Zhudong et al. Journal of Alloys and Compounds[J], 2020, 829: 154487
- [8] Zhen Xiaohua(郑晓华), Yang Fanger(杨芳儿), Zhang Lingjie(张 玲洁) et al. Rare Metal Materials and Engineering(稀有金属材料 与工程)[J], 2016, 45(S1): 206
- [9] Swingler, Sumption A. Rare Metals[J], 2010, 29(3): 248
- [10] Chen Ling(陈 令), Wang Jingqin(王景芹), Zhu Yancai(朱艳彩) et al. Journal of Synthetic Crystals(人工晶体学报)[J], 2019, 48(11): 2056
- [11] Wang Jingqin, Liu Zhou, Chen Ling et al. Materials[J], 2019, 12(14)
- [12] Fu Chong(付 翀), Zhang Yuhui(张字慧), Wang Junbo(王俊勃) et al. Nonferrous Metals(有色金属工程)[J], 2016, 6(4): 30
- [13] Zhou Xiaolong(周晓龙), Zhen Zhong(郑忠), Yu Jie(于杰) et al. Hot Working Technology(热加工工艺)[J], 2015, 44 (24):1
- [14] Zhao Caotian(赵彩甜), Wang Jingqin(王景芹), Cai Yanan(蔡亚楠) et al. The Chinese Journal of Nonferrous Metals(中国有色金属学报)[J], 2017, 27(12): 2552
- [15] Wang Jiazhen(王家真), Wang Yaping(王亚平), Yang Zhimao(杨 志懋) et al. Rare Metal Materials and Engineering(稀有金属材 料与工程)[J], 2005, 34(3): 405
- [16] Zhen Xiaohua(郑晓华), Wu Junchen(吴君臣), Wang Guicong (王贵葱) et al. Rare Metal Materials and Engineering(稀有金 属材料与工程)[J], 2020, 49(7): 2494
- [17] Wang Haitao(王海涛), Liang Lei(梁 磊), Wen Panlong(文攀龙) et al. Precious Metals(贵金属)[J], 2016, 37(4): 21
- [18] Chen Yong(陈 勇), Li Heqin(李合琴), Feng Xuqiang(冯旭强) et al. Rare Metals and Cemented Carbides(稀有金属与硬质合 金)[J], 2020, 48(2): 63
- [19] Wu Xinhe(吴新合), Yang Hui(杨 辉), Qi Gengxin(祁更新) et al. Electrical Materials(电工材料)[J], 2019, 47(5): 6
- [20] Liu Hui(刘 辉), Tan Xiangzhong(覃向忠). Electrical Materials (电工材料)[J], 2007, 35(1): 15
- [21] Wu Chunping, Yuan Meng, Wu Qiong et al. Journal of Alloys and Compounds[J], 2020, 826: 154 146

Effect of Bi₂Sn₂O₇ Doping on Interfacial Wettability and Physical Properties of Ag/SnO₂ Materials

Zheng Xiaohua¹, Wang Chun¹, Shen Tao², Qin Haibo¹, Yang Fanger¹

(1. Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310014, China)

(2. Zhejiang University, Hangzhou 310027, China)

Abstract: Using bismuth stannate (Bi₂Sn₂O₇) synthesized by chemical coprecipitation as modified component, the effect of Bi₂Sn₂O₇ doping on the wetting angle of Ag/SnO₂ interface was studied by the sessile drop method. The Ag/SnO₂(*x*)-Bi₂Sn₂O₇(*y*) electrical contact materials were prepared by mechanical alloying technique combined with molding sintering process. The phase structure, electrical and mechanical properties of the materials were characterized by SEM, XRD, OCA, resistance tester, hardness tester and densimeter. The results show that Bi₂Sn₂O₇ doping can significantly improve the interfacial wettability between Ag and SnO₂, and the minimum wetting angle is 82 ° when the mass fraction of Bi₂Sn₂O₇ is 16.7%. The lower resistivity of Ag/SnO₂(*x*)-Bi₂Sn₂O₇ is 2wt%, the resistivity reaches the lowest value (2.28 $\mu\Omega$ ·cm), and the relative density (96.96%) and hardness HV_{0.3} (900 MPa) reach the maximum value.

Key words: Ag/SnO₂; Bi₂Sn₂O₇ doping; electrical contact material; wettability; resistivity

Corresponding author: Zheng Xiaohua, Ph. D., Associate Professor, College of Materials Science and Engineering, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310014, P. R. China, Tel: 0086-571-88320479, E-mail: zhengxh@zjut.edu.cn